He²⁺离子与 H 原子的重粒子碰撞电离过程*

宁 μ^{1}) 何 dd^{2}) 刘春雷²) 颜 君²) 王建国²)

¹(中国工程物理研究院研究生部,北京 100088)
 ²(北京应用物理与计算数学研究所计算物理实验室,北京 100088)
 (2004 年 8 月 14 日收到,2004 年 11 月 25 日收到修改稿)

利用初态程函近似的连续扭曲波方法研究了 He²⁺离子与 H 原子的碰撞电离过程.计算得到了入射离子能量 从 30keV/u 到 2000keV/u 的碰撞电离总截面、随电离电子能量和角度变化的一阶和二阶微分散射截面,及随入射离 子能量变化的电离电子平均能量.计算的总电离截面与其他理论和实验结果进行了比较,在入射离子能量大于 100keV/u 的能区,计算结果与实验符合得很好;在较低的能区,各种理论结果之间有较大差别,计算结果比实验约 小 50%.利用计算的二阶微分散射截面讨论了软碰撞、电子俘获到入射离子连续态、两体相遇碰撞等碰撞电离 机理.

关键词:重粒子碰撞电离,初态程函近似,总截面,一阶和二阶微分散射截面 PACC:2410F,0365N

1.引 言

重粒子碰撞过程在许多实际问题中扮演着重要 角色、如核裂变反应堆、磁约束聚变等离子体中性束 注入加热、带电粒子横穿物质时能量损失的效率等 等^[1]在天体物理中的一些现象也与粒子碰撞息息 相关.如木星极光被认为是由于多电荷的 Ω^{q+} 和 S^{q+}离子(可能还有 Na^{q+},C^{q+}和 Si^{q+}之类的离子)与 木星大气层中 H, He, H, 发生碰撞产生的²¹.在惯性 约束聚变(inertial controlled fusion, ICF)实验中,强激 光打靶后靶丸内会产生大量的高能离子,其中包括 了聚变产物——高能 He²⁺ 离子(能量大约为 3.5MeV) 被加热的 H D T 离子等 这些高能粒子产 生后将与靶丸内和靶壁的原子、离子发生碰撞过程, 研究这些离子的输运过程和诊断这些离子在靶丸内 的空间分布 进而推断被压缩后的靶丸形状和状态 对于 ICF 的研究具有十分重要的意义.重粒子之间 的碰撞可以发生多种过程,包括激发、电离、单(多) 电子俘获及相关的自电离和 x 射线发射等.在这些 过程中 重粒子碰撞电离的研究一直备受关注 这是 因为该过程的电离电子包含了原子结构以及碰撞机 理的重要信息,有很多理论和实验物理学家开展这

方面的研究工作,并发现了多种碰撞电离机 理^[1,3—14]。但由于碰撞过程中涉及的双(或多)中心 多体问题本身的复杂性,直到今天这仍是一个远未 完善的研究领域.

本文研究的碰撞电离反应是

 $He^{2+} + H \longrightarrow He^{2+} + H^+ + e^-$ (1)氢和氦是天体物理环境中丰度最高的两种元素、氢 同位素是磁约束和惯性约束聚变的燃料 氨是聚变 产物.氦和氢也是低温气体放电等离子体中的重要 元素,它们之间发生的碰撞电离反应(1)在这些领域 的研究中往往是一个必须考虑的重要过程,因为它 涉及到氢元素的电离平衡、电子离子的密度变化、 α 粒子的能量转移和输运等多个问题,同时,作为一个 典型的三体问题也有基础理论研究意义,并由于它 是最简单的非对称重粒子碰撞体系,可以用来进行 各种计算方法和模型的相互检验,针对该反应已经 发表了大量的实验和理论工作^[14—18]. Shah 等利用交 叉束和同时测量技术得到了入射离子能量从 18.6keV/u到 550keV/u 的碰撞电离的总截面^[15,16]。 理论上有一级玻恩近似^[4], Glauber 近似^[17], CTMC 方 法^{18]},包含程函近似的连续扭曲波(continuum distorted-wave method with the eikonal initial-state approximation ,CDW-EIS)模型^[19],原子轨道强耦合模

^{*}国家自然科学基金(批准号:10344001和10174009)和中国工程物理研究院科学技术基金资助的课题。

型^[20 21]等不同处理方法.据我们所知,以前的实验和 理论文献中,只给出了碰撞电离的总截面,并没有一 阶或二阶微分截面的结果.因此,本文利用 CDW-EIS 方法计算了 He²⁺离子与氢碰撞电离的总截面、随电 离电子能量和角度变化的一阶和二阶微分散射截 面,以及随入射离子能量变化的电离电子平均能量, 探讨了该体系碰撞电离的各种机理.计算的总截面 与其他理论和实验结果进行了对比.

2. 理论方法

本文所使用的扭曲波程函近似方法是在不断修 正一系列以前的理论方法的基础上发展起来 的^[19,22,23].一般理论把粒子碰撞电离这一三体问题 看成是从一个通道向另一个通道的跃迁.该跃迁概 率直接关联到电离电子的散射截面.理论分析往往 用散射矩阵元表示该跃迁概率,只是不同理论对于 初、末态波函数的选择以及相互作用势的取舍是不 同的^[22].最简单的方法是把入射离子的静电势当成 微扰即一阶玻恩近似方法,假设靶中电子感受的有 效电荷为 Z_T,入射离子电荷为 Z_P,则初、末态的波 函数分别为^[8](除非特别说明,本文一律采用原子 单位)

$$\Phi_i^{\text{FBA}}(\mathbf{r}, t)$$

$$= \phi_i(\mathbf{r}_{\text{T}}) \exp\left(-\mathrm{i}\boldsymbol{\varepsilon}_i t - \frac{1}{2}\mathrm{i}\boldsymbol{\upsilon} \cdot \mathbf{r} - \frac{1}{8}\mathrm{i}\upsilon^2 t\right), (2)$$

$$\Phi_f^{\text{FBA}}(\mathbf{r}, t)$$

$$= (2\pi)^{-3/2} \exp\left(\mathrm{i}\boldsymbol{k} \cdot \mathbf{r}_{\text{T}} - \mathrm{i}E_j t - \frac{1}{2}\mathrm{i}\boldsymbol{\upsilon} \cdot \mathbf{r} - \frac{1}{8}\mathrm{i}\upsilon^2 t\right)$$

× $N^*(\xi)_1 F_1(-i\xi;1;-ikr_T - ik \cdot r_T)(3)$ 式中 r_T 和 r_P 分别为在实验室坐标系中电子相对于 靶和入射离子的位置, $r = (r_T + r_P)/2; \phi_i(r_T)$ 表示 初始处于束缚态电子的归一化波函数, ϵ_i 为其束缚 能; v 表示靶与入射离子的相对运动速度, k 是末态 电离电子的动量, E_k 为电离电子的动能, $E_k = k^2/2$. $N(a) = \exp(\pi a/2)\Gamma(1 - ia)$ 是连续波函数的归一化 因子,并满足边界条件,这里 $\xi = Z_T/k$. 玻恩一级近 似的微扰量是靶中电子与入射离子之间的库仑相互 作用, 因此在入射离子电离度过高或入射离子与靶 间的距离过小时玻恩一级近似都不成立, 因为此时 入射离子的静电势已不能作为微扰来处理. 在实际 应用中, 一级玻恩近似不适于处理较低能区的碰撞 电离过程,也无法解释实验中所观测到的电子转移 到入射离子连续态(electron captured to continuum state,ECC^[11])的碰撞电离机理.为此,必须考虑库仑 势对初、末态波函数的扭曲,采用连续扭曲波 (continuum distorted-wave,CDW)近似方法.扭曲波方 法的初态波函数选择如下^[19]:

$$\Psi_{i}^{+\text{CDW}} = \Phi_{i}^{\text{FBA}}(\mathbf{r}, t)\chi_{i} , \qquad (4a)$$

$$\chi_{i} \equiv \exp\left(i\frac{Z_{1}Z_{3}}{\upsilon}\ln(\upsilon R - \upsilon \cdot \mathbf{R})\right)$$

$$\times M(\upsilon) F_{1}(i\upsilon; 1 ; i\upsilon s + i\upsilon \cdot s), (4b)$$

$$\Psi_{f}^{-CDW} = (2\pi)^{3/2} N^{*} (\xi) N^{*} (\zeta) \exp\left(i\boldsymbol{k} \cdot \boldsymbol{r}_{T} - iE_{k}t - \frac{1}{2}i\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{r} - i\frac{1}{8}v^{2}t\right)$$
$$\times {}_{1}F_{1} (-i\xi; 1; -i(kr_{T} + \boldsymbol{k} \cdot \boldsymbol{r}_{T}))$$
$$\times {}_{1}F_{1} (-i\xi; 1; -i(pr_{P} + \boldsymbol{p} \cdot \boldsymbol{r}_{P})) (5)$$

式中 $\zeta = Z_{\rm P}/p$, $\nu = Z_{\rm P}/v$, p = k - v. (5)式中合流超 几何函数₁ F_1 ($-i\zeta$;1; $-i(pr_P + p \cdot r_P)$)包含了入射 离子对电离电子的扭曲作用[1].另外(5)式中出现的 N*(と)的平方被称为 Salin 因子,正是这一项的修正 才使得 CDW 方法能很好地描述 ECC 峰^[24] 连续扭 曲波在高能区趋近于玻恩一级近似,与实验符合得 很好.然而,在中能区,CDW的值高于实验值,而且, 对于电子俘获的计算也出现同样的问题 这些问题 的出现被认为是因为 CDW 初态拟合的波函数没有 被正确归一化[19].为此,人们提出用初态程函近似 替代 CDW 中的扭曲库仑因子,这就是 CDW-EIS 方 法^{19]}该方法的依据是电离电子能量很低的软碰撞 占据总散射截面的主要部分.CDW-EIS 方法不仅成 功解释了 ECC 峰,并且被成功运用于描述多种体系 的一阶、二阶微分散射截面与总截面.在 CDW-EIS 理论中初态的波函数选择如下^[19]:

$$\Psi_{i}^{+\text{EIS}} = \phi_{i} (\mathbf{r}_{\text{T}}) \exp\left(-\frac{1}{2} \mathrm{i} \boldsymbol{\upsilon} \cdot \mathbf{r} - \frac{1}{8} \mathrm{i} \upsilon^{2} t - \mathrm{i} \boldsymbol{\varepsilon}_{i} t\right) \\ \times \exp\left(-\mathrm{i} \upsilon \ln (\upsilon r_{\text{P}} + \boldsymbol{\upsilon} \cdot \mathbf{r}_{\text{P}})\right), \qquad (6)$$

比较(2)(6)两式可以看出 CDW-EIS 初态波函数的 选择是在一级玻恩近似的基础上引入了指数项的程 函扭曲因子,跃迁振幅为^[19]

$$a_{ij}(\boldsymbol{\rho}) = -i\int_{-\infty}^{\infty} dt \Psi_{i}^{+\text{EIS}} \left| H_{e} - i\frac{\partial}{\partial t_{r}} \right| \Psi_{k}^{-\text{CDW}} ,$$
(7)

这里的哈密顿量定义为

$$H_{\rm e} = -\frac{1}{2} \nabla_r^2 - \frac{Z_{\rm T}}{r_{\rm T}} - \frac{Z_{\rm P}}{r_{\rm P}}.$$
 (8)

于是,三阶微分散射截面就可以表达为

$$Q(\mathbf{k}) = \int d\rho |a_{ik}(\mathbf{\rho})|^2$$
, (9)

在此基础上可以得到随电离电子能量和相对于入射 离子角度变化的二阶微分散射截面

$$\frac{\mathrm{d}^2 \sigma}{\mathrm{d} E_k \,\mathrm{d} \theta} = k \int_{0}^{2\pi} \mathrm{d} \phi Q(\mathbf{k}), \qquad (10)$$

分别随电离电子角度和能量变化的一阶微分散射 截面

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\theta} = \int \mathrm{d}E_k \sigma (E_k , \theta), \qquad (11a)$$

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}E_k} = \int \mathrm{d}\theta \sin\theta \sigma (E_k \ \theta), \qquad (11b)$$

和碰撞电离的总截面

$$\sigma_{\text{tot}} = \int_0^{\pi} \mathrm{d}\theta \sin\theta \sigma (\theta) = \int_0^{\infty} \mathrm{d}E_k \sigma (E_k). \quad (12)$$

3. 结果与讨论

利用 CDW-EIS 方法研究了 He²⁺ 离子与氢原子 碰撞电离过程,得到了入射离子能量从 30keV/u 到 2000keV/u 的碰撞电离总截面,电离电子能量从 0.2eV 到 4*T*($T = 1/2m_ev^2$,即电子以入射离子速度 运动的能量) 电离电子相对入射离子运动方向从 0°到 180°的一阶、二阶微分散射截面,以及随入射离 子能量变化的平均电离电子能量.

3.1. 碰撞电离的二阶微分散射截面

利用(10)式可以得到随电离电子能量和角度变 化的二阶微分散射截面.图1是入射离子能量为 100keV/u时的二阶微分散射截面.当电离电子的出 射角度固定于零度时,随电离电子能量变化的二阶 微分散射截面有三个峰值.靠近能量零点附近的峰 是软碰撞(soft collision,SC)峰,它来源于靶-氢原子 被入射离子碰撞扰动后,靶中的电子被激发到连续 态而形成电离,该电离机理产生的电子能量较低,基 本处于靶的连续态.在电离电子能量大约为 50eV 附 近,有一个非常尖锐的峰值,该峰是靶中的电子被俘 获到入射离子连续态的 ECC 峰,此时电离电子几乎 与入射离子保持相同的速度和方向发射出来,因此 它具有的能量约为*T*.在入射离子能量为 100keV/u

的情况下 ECC 峰值估计大约为 54eV 这与图 1 中 的结果是一致的,在电离电子能量大约为 200eV 附 近,有一个比较平的高能峰,它来源于两体相遇碰撞 (binary encounter ,BE)峰¹⁰],即入射离子与靶中的电 子有较强的相互作用 导致大的动量转移 电离电子 获得很高的能量,此时,靶对电离电子的影响可以暂 不考虑 入射离子与电离电子的相互作用近似为两 体相互作用,假设电子在入射离子的运动方向动量 为零 利用能动量守恒规则 电离电子获得的能量为 $E_a = 4T\cos^2 \theta^{[10,23]}$, θ 为电离电子与入射离子的夹 角,但由于靶中束缚电子有一定的动量分布,所以 BE 峰并不是很锐的峰,而具有一定的展宽,它的形 状即是典型的康普顿线形[25] 随着电子出射角度的 增加 SC 峰单调减小 大于 120°以后的大角散射随 角度的变化不大 :ECC 峰则迅速减小 大于 20°以后 已经看不到了 这是因为 ECC 电子应该与入射离子 一起运动,基本保持同一个方向;BE峰的位置连续 向低能方向移动并形成一条高能的脊基本符合 E. $=4T\cos^2\theta$ 的关系。但在发射角度大于 60°时。BE 峰 逐渐变得不明显,这是由于靶中电子的动量分布已 经可与电离电子动量相比 此时两体相遇碰撞机理 不再成立 三体或者说双中心效应起了作用 同时也 与SC峰重叠起来。



图 1 入射 He²⁺离子能量为 100keV/u 时.随电离电子能量和角 度变化的二阶微分截面

图 2 给出入射 He²⁺ 离子能量为 400keV/u 时,随 电离电子能量和角度变化的二阶微分截面.在该图 中仍可见到 SC 峰、ECC 峰和 BE 峰形成的脊.但在 定量上与图 1 还是有所不同.首先,ECC 峰和 BE 峰 相对 SC 峰的比值要比入射离子能量为 100keV/u 的 图 1 小 2 到 3 个量级,这是由于 400keV/u 能量的入 射离子要比 100keV/u 的离子运动速度快一倍,在它 与靶相互作用的时候,没有足够的时间俘获大量的 电子到自己的连续态,也没有足够的时间转移大的 动量给靶中的电子形成大的 BE 峰.根据我们的计 算结果可以总结出以下规律:随着入射离子能量的 增加,电离电子中 ECC 峰和 BE 峰的份额越来越少, 高能重粒子碰撞电离过程的主要机理是软碰撞.其 次对比图1和图2中的 SC 峰,可以看到高能入射 离子的情况,SC 峰随角度的变化不大,但入射离子 能量较低的时候,SC 峰随角度的变化要相对大 得多.



图 2 入射 He²⁺离子能量为 400keV/u 时,随电离电子能量和角 度变化的二阶微分截面

3.2. 碰撞电离的一阶微分散射截面

利用(11)式和(12)式可以分别得到随电离电子 角度和能量变化的一阶微分散射截面.图 3 是入射 离子能量分别为 50keV/u,100keV/u,400keV/u 和 800keV/u时随电离电子角度变化的一阶微分散射 截面.

可以看到电离电子主要是前向散射,特别是较低入射离子能量的情况,峰值位置在零度角附近.随着入射离子能量的增加,一阶微分截面的峰值向90°方向移动,预期在极高能的情况下,峰值会在90°角附近出现.其原因可以从经典角度解释如下:在离子入射过程中不断靠近靶,从而对靶核与靶中的电子的库仑力也在不断增加,这一过程的库仑力使得靶中的电子与靶核的距离变大,其结果是削弱了靶核对电子的吸引力,使靶的结构变得松散,而当入射离子离开靶时,入射离子与电子间的库仑力将这靶中



图 3 随电离电子出射角度变化的一阶微分散射截面.入射离子 能量分别为 50keV/u("+"),100keV/u("○"),400keV/u("☆")和 800keV/u("■")

的电子吸引过来,向着靠近入射离子的方向运动.而 离子在入射过程中"松散'靶结构作用的强弱是与入 射离子的能量相关的.离子能量越低,离子与靶的作 用时间相对越长,它对靶的'松散'作用也就越明显, 当入射离子离开靶的时候,就越容易带动电子向前 运动而形成小角度的电离现象,相反,高能入射离子 运动速度快,与靶的相互作用时间短,对于靶中的电 子作用主要集中在与靶距离较小时的区域,而这时 的作用力的方向是靠近90°的,导致电离电子的方向 有向90°方向偏移的趋势.于是在现象上我们看到在 较低入射离子能量的情况下,散射主要在小角度方 向,随着能量增加,向大角度方向移动.

图 4 是入射离子能量分别为 50keV/u, 100keV/u 400keV/u 和 800keV/u 时随电离电子能量 变化的一阶微分散射截面.

从图中可以看到,一阶微分散射截面随电离电 子能量增加单调下降,截面以电离电子在低能区的 软碰撞为主,特别是对高能量入射离子的情况,软碰 撞机理所占的比重更大.对 50keV/u 的入射离子能 量,在电子能量 0 到 27.2eV 有一个截面缓变区,这 应归于 ECC 峰(电子能量在 27.2eV 左右,见图 4 (a))对截面的贡献,大于 27.2eV 时截面快速下降. 随入射离子能量增加,ECC 效应的影响越来越小,在 图 4 中的其他能量曲线,已看不到 ECC 效应的影 响.虽然在图 1 和图 2 的二阶微分截面中可见到 ECC 尖锐峰,但积分以后贡献太小.在入射离子能量 为 100keV/u,400keV/u 和 800keV/u 时,截面都有一 个长的缓慢下降的平台,然后很快下降.平台主要是 BE 峰产生的,由于 BE 峰随角度连续变化,积分后



图 4 随电离电子能量变化的一阶微分散射截面.入射离子能量 分别为 50keV/u("○"),100keV/u("+"),400keV/u("☆")和 800keV/u("■")

看不到 BE 峰的脊,但形成了一个平台.在 50keV/u 的入射离子能量情况下,由于 ECC 峰的影响(它与 SC 峰形成截面缓变区),BE 峰产生的平台不明显. 总的来说,电离电子主要来源于软碰撞机理,入射离 子能量低的时候,ECC 效应的影响较大.BE 机理对 总截面的影响不大,但它产生了较高能量的电离 电子.

3.3. 电离电子的平均能量

在我们计算的较高能区(大于 100keV/u),高能 粒子通过碰撞损失能量的机理主要是碰撞电离.在 天体物理应用中,人们往往利用被电离电子的平均 能量来定量地估计高能离子在星际空间、大气等环 境中的能量损失,因此电离电子的平均能量是一个重 要的应用参量.利用 3.2 节中的随电离电子能量变化 的一阶微分截面,可以计算电离电子的平均能量

$$\overline{E} = \frac{\int_{0}^{\max} E_k \frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}E_k} \mathrm{d}E_k}{\int_{0}^{E_{\max}} \frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}E_k} \mathrm{d}E_k} , \qquad (13)$$

这里 *E*_{max}是对电子能量积分的上限.在表 1 中给出 了随入射离子能量变化的电离电子平均能量.入射 离子能量大于 50keV/u 时,电离电子平均能量随入 射离子能量的变化并不大.原因是碰撞电离主要来 源于软碰撞,软碰撞电子的能量与入射离子的能量 变化关系不大.在软碰撞机理中,入射离子基本作为 一个微扰量,对入射离子的能量不是很敏感.ECC 和 BE 机理产生的电子则与入射离子能量成正比,但它 们的电离截面都比较小,不足以对平均电子能量产 生太大的影响.由于电离截面随能量增加迅速减小 (见图 5),电离电子的能量随入射离子能量的变化 不大,这将直接导致高能离子的能量损失率随入射 离子能量增加迅速减小,这与文献 24]的结果是一 致的.

表1 随入射离子能量变化的电离电子平均能量

电离离子能量(keV/u)	出射电子平均能量/eV
30	15.2179
50	19.8311
60	20.2715
80	21.2326
100	21.6948
200	22.1207
400	22.6076
800	24.1372
1000	24.4674
2000	26.0159

3.4. 碰撞电离的总截面

利用(13)式可以得到碰撞电离的总截面.图5 是计算的总截面并与其他的理论和实验结果进行了 对比 图 5 给出了计算的 CTMC 结果(计算细节见文 献 18 ,25]). 可以看到在小于 100keV/u 的较低能 区 各种理论方法计算结果的差距都比较大,与实验 相比 "Shingal 和 Lin^[21]的原子轨道强耦合计算与实 验符合得最好 这表明对低能区的重离子碰撞电离 过程 非微扰的计算是必须的 Winter^{20]}的三中心原 子轨道强耦合计算与实验符合得并不是很好,主要 的原因是连续态的基展开只固定在一个中心上,未 包含其他两中心连续态展开211.一阶玻恩近似和 Glauber 近似与实验的差距最大,因为它们都是一阶 近似,这是可以理解的,我们的 CDW-EIS 计算方法 与 Crothers 和 McCann^[19]的计算是一样的,只是对 (10)--(13) 式的积分我们用梯形公式进行计算,避 免了 Crothers 和 McCartney^[26]利用高斯型积分计算的 不收敛问题 不收敛主要是由于被积函数的高震荡 性产生的 两种积分导致的最终总截面差距在几个 百分点以内 考虑到这是多维积分 这样的差距应该 是合理的,在低能区 CDW-EIS 的结果低估了截面从 10% 到大约 50% 这基本代表了 CDW-EIS 在低能区 的计算精度.CTMC 计算在低能区的精度比 CDW-EIS 还要低一些,主要是在低能区电子的量子行为

更加明显.



图 5 He²⁺ 离子与氢原子碰撞电离的总截面.1 为本文的 CDW-EIS 结果 ;2 为本文的 CTMC 结果 ;3 为一级玻恩近似^[4];4 为 Glauber 近似^[17]5 为 CDW-EIS^[19]6 为三中心原子轴道强耦合近 似^[20]7 为双中心原子轨道强耦合近似^[21]8 为实验数据^[15]9 为实验数据^[16]

在大于 100keV/u 的较高能区,我们的 CDW-EIS 和 CTMC 结果与实验符合得都比较好,Glaubers¹⁷³和 一阶玻恩^[4]近似也是在更高的能区与实验符合得较 好.Shingal 和 Lin^[21]的原子轨道理论在低能区与实

- [1] Belkić D Ž 1978 J. Phys. B 11 3529
- [2] Krasnopolsky V A et al 2002 Astrophys. J. 549 629
- [3] Rutherford E 1911 Phil. Mag. 21 669
- [4] Bates D R and Griffing G 1953 Proc. Phys. Soc. A 66 961
- [5] Abrines R and Percival I C 1996 Proc. L. Phys. Soc. 88 861 Abrines R and Percival I C 1996 Proc. L. Phys. Soc. 88 873
- [6] Bang J and Handteen J M 1959 Mat. Phys. Medd. Dan. Vid. Selesk. 31 (13) 43
- [7] Salin A 1969 J. Phys. B 2 631
- [8] McDowell M R C and Coleman J P 1970 Introduction To the Theory of Ion-Atom Collisions (Amsterdam :North-Holland)
- [9] Coleman J P 1969 Case Studies in Atomic Collisions ,Invited Talks.
- [10] Rudd M E and Jorgensen T Jr 1963 Phys. Rev. 131 666
- [11] Crooks G B and Rudd M E 1970 Phys. Rev. Lett. 25 1599
- [12] Stolterfoht N 1987 Phys. Reports 146 315
- [13] Schneider D et al 1989 Phys. Rev. A 46 1296

验符合得好,在高能区差距逐渐增大,大于 400keV/u 时精度已经不如 CDW-EIS 高,主要是原子轨道展开 的赝连续态基已经不能很好地描述真实的连续态. 由于这是比较早期的总截面实验,还不能非常清楚 地说明所有的问题.希望能有一些新的实验测量,特 别是一阶、二阶微分截面的测量,来进一步校验我们 的理论计算.

4. 结 论

本文利用 CDW-EIS 方法研究了 He²⁺ + H 体系 的碰撞电离过程,给出了这一过程总的碰撞电离截 面、随电离电子能量变化及出射角度变化的一阶微 分散射截面和二阶微分散射截面,以及随入射离子 能量变化的电离电子平均能量.并将总截面的结果 与其他理论以及实验的结果作了比较.利用二阶微 分散射截面讨论了各种碰撞电离机理.总的来说, CDW-EIS 方法能够较好地定量描述较高能区的碰撞 电离过程,并给出相关的各种碰撞参数,满足实际应 用的需要.预期下一步的工作将进一步研究其他更 复杂的带电离子的碰撞电离过程.

- [14] Pedersen J O et al 1990 J. Phys. B 24 4001
- [15] Shah M B and Gilbody H B 1981 J. Phys. B 14 2361
- [16] Shah M B et al 1988 J. Phys. B 21 2455
- [17] Golden J E and McGuire J H 1976 J. Phys. B 9 L11
- [18] Olson R E and Salop A 1977 Phys. Rev. A 16 531
- [19] Crothers D S F and McCann J F 1983 J. Phys. B 16 3229
- [20] Winter T G 1988 Phys. Rev. A 37 4656
- [21] Shingal R and Lin C D 1989 J. Phys. B 22 L445
- [22] Fainstein P D et al 1991 J. Phys. B 24 3091
- [23] Stolterfoht N et al 1997 Electron Emission in Heavy Ion-Atom Collisions (Springer-Verlag, Heidelberg)
- [24] Ziegler J F 1977 Helium Stopping Power and Ranges in All Elemental Matters (Pregaman Press, New York)
- [25] Wang J G et al 2002 J. Phys. B 35 3137
- [26] Crothers D S F and McCartney M 1992 Computer Phys. Communications 72 288

CDW-EIS calculation in He²⁺ + H impact ionization*

Ning Ye¹) He Bin²) Liu Chun-Lei²) Yan Jun²) Wang Jian-Guo²)

¹) (China Academy of Engineering Physics 100088)

 2 (The Key Laboratory of Computational Physics , the Institute of Applied Physics and Computational Mathematics 100088)

(Received 14 August 2004 ; revised manuscript received 25 November 2004)

Abstract

The He^{2+} + H Impact Ionization process is investigated using a continuum distorted wave method with the eikonal initialstate(CDW-EIS) approximation. The total ,single- and double-differential cross sections are obtained in the projectile energy ranges from 30keV/u to 2000keV/u. The total cross sections are compared with the existing theoretical and experimental data. When the projectile energy is larger than 100keV/u ,our results are in good agreement with the experimental measurements ,while about 50% less than experimental data in the lower energy range. The ionization mechanism of soft-collisions ,electron captured to continuum states and binary-encounter collisions are also displayed.

Keywords : heavy particle impact ionization, continuum distorted wave-eikonal initial approximation, total cross section, singleand double-differential cross section

PACC: 2410F, 0365N

^{*} Project supported by National Science Fundation of China Grand Nos.0344001 and 10174009) and Science and Technology Fundation of Chinese Academy of Engineering Physics.